
	<h2>SI8416DB-T2-E1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8416DB-T2-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 8V 16A MICRO</p> <p>Datenblätter:  SI8416DB-T2-E1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

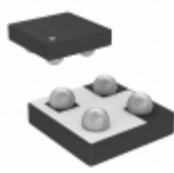


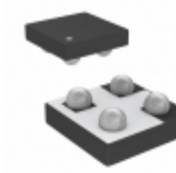


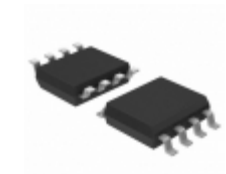
Spezifikationen

Teilenummer	SI8416DB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V 16A MICRO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Vgs (Max)	±5V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-Micro Foot™ (1.5x1)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.77W (Ta), 13W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UFBGA
Andere Namen	SI8416DB-T2-E1-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1470pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 8V 16A (Tc) 2.77W (Ta), 13W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SI8416DB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8416DB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8416DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI8416DB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8415DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.3A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8417DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 14.5A 2X2 6MFP</p>	 <p>SI8416DB-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 16A MICRO</p>	 <p>SI8415DB-T1-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.3A 2X2 4-MFP</p>
 <p>SI8417DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 14.5A 2X2 6MFP</p>	 <p>SI8420-B-IS Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p>SI8420-A-IS Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p>SI8416DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 16A MICRO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8416DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI8416DB-T2-E1 Datenblatt	SI8416DB-T2-E1-Datenblätter	SI8416DB-T2-E1 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI8416DB-T2-E1
SI8416DB-T2-E1 Electronic	SI8416DB-T2-E1-Komponenten	SI8416DB-T2-E1-Verteiler	SI8416DB-T2-E1-Bild	SI8416DB-T2-E1-Teil
SI8416DB-T2-E1 Preis	SI8416DB-T2-E1 Hersteller	SI8416DB-T2-E1 Bild	SI8416DB-T2-E1 Aktie	SI8416DB-T2-E1 Inventar
SI8416DB-T2-E1 Neu	SI8416DB-T2-E1 Original	SI8416DB-T2-E1 garantiert	SI8416DB-T2-E1 RFQ	SI8416DB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited